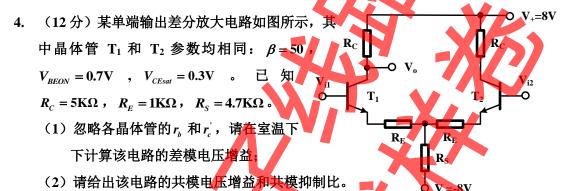
中国科学技术大学 xxxx 年xx学期考试试卷(A卷)

考证	式科目: <u>线性电子线路(B</u>)		得分:
学生	上所在系: 姓名	:	学号
<u>(提</u>	示:所有答案请写在答题纸上,试卷上	:答题无效)	7
– ,	填空题(每空2分,共24分)		VK
1.	本征半导体受热激发成对产生	和一的过程和	弥为本征激发,其产生的 载
:	流子数目与温度有关。		V
2.	由双极型晶体管构成的三种组态基本的	文大器中,	放大器具有最低的输入阻
;	抗,放大器又被称为射极跟随	器。	にト
3.	集成运算放大器 μA741 在其内部使用的	的级间耦合方式为	,且输入级常采用电
	路参数相互补偿的原理来抑制	-7	
	为了同时提高某放大器 <mark>的</mark> 输入阻抗和		
	为,此时该反馈函数的类型为		
	某恒流源电路由 N 沟道 JFET 构成,		
	$V_{CS} = -1$ V 时测得 $V_{OS} = 2.8$ V,则此时该	逐管被偏置在	_区,消耗在该管上的功率
	为mW。	// //	
	一个 2N2222A 双极型晶体管工作于放	_	-
	若测得该管基极电流 $I_B = 15$ μA,发射		则该管的共发电流放大系
	数 $\beta = 1$,其共发截止频率 f_{β}	MHz。	
二、	计算题(共76分)		
1.	(10 分) 两枚相同的二极管 D ₁ 和 D ₂ 构	成图示由路.	
	$\langle 1 \rangle$ 假设 I_s 已知,请写出 V_x 关于 I_x 的		\bigcup \bigcup \bigcup D_1 $\overset{\smile}{+}$
	(2) 若使用恒压模型替代二极管,假设	T /	\mathbf{A}
	请重新表达 V_X 与 I_X 的关系。	- Don -//	
			1018
2,	(10分)某负反馈放大器的开环增益函	数 $A(s) = \frac{1}{(s+10^3)(s)}$	· +5×10 ⁴)(s+10 ⁶),其反馈
þ	网络完全由电阻构成,试分析产生 60%		

器的低频闭环增益。

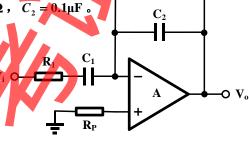
- 3. (12 分)观察右图所示放大电路,已知晶体管 T 的 共基电流增益 α =0.99 , V_{BEon} = 0.7V , V_{CEsat} = 0.3V 。 电容 C_1 = 10 μ F ,其他参数已经在图中标出。
 - (1) 请设计电阻 R_E 和 R_C ,使得晶体管 T 的直流 工作点满足 I_{CO} =5mA , V_{CEO} =5V ;
 - (2) 忽略晶体管 T 的 r_b 和 r_c ,请在室温下计算 该电路的中频输入阻抗。



- 已知 $R_1 = 1$ K Ω , $C_1 = 1$ μ F , $R_2 = R_3 = 200\Omega$, $C_2 = 0.1$ μ F 。

5. (16分)由理想运算放大器 A 构成的应用电路如下图所示,

- (1) 请判断反馈类型及运放的工作状态;
- (2) 试计算电压传递函数 $A_{r}(s)$;
- (3) 绘制 $A_v(s)$ 的幅频波特图;
- (4) 求中频电压增益和 3dB 截止频率



 \circ $V_{CC}=10V$

 \bullet V_i

 $\mathbf{R}_{\mathbf{C}}$

 $\mathbf{R}_{\mathbf{E}}$

 $R_1 = 68K\Omega$

 C_1

R₂= 36ΚΩ

- 6. (16 分)观察图示两级放大器,其中增强型 MOS 管 T_1 和 T_2 的参数完全一致: $K_n=2\text{mA/V}^2,V_T=1\text{V}$, r_d 可忽略,且C 、C 和 C_3 为大电容。
 - (1) $R_{D_{01}}$, $I_{D_{02}}$, $V_{DS_{01}}$ $RV_{DS_{02}}$;
 - (2) 求 g_{m1} 和 g_{m2} ;
 - (3) 求两级放大器的中频电压增益 $A_{V} = V_{a}/V_{i}$ 。

